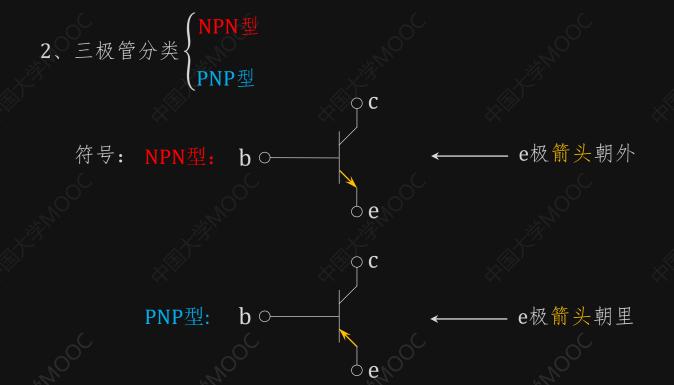
1、三极管的基本组成

包含三个电极:发射极e、基极b、集电极c 三极管 {包含三个区:发射区、基区、集电区

包含两个PN结:发射结(发射极e和基极b之间的PN结)、集电结(集电极c和基极b之间的PN结)

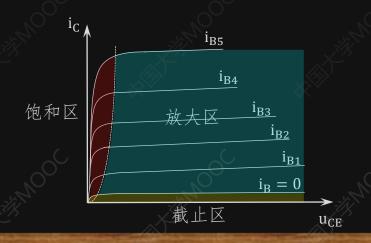


3、三极管的三种工作状态: 放大、饱和、截止 三极管工作状态的条件:

放大状态	少年十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	集电结反偏
饱和状态	发射结正偏	集电结正偏
截止状态	发射结反偏	

4、三极管特性曲线

输出特性曲线:



三极管工作状态的电压条件:

放大区: $u_{BE} > U_{on} 且 u_{CE} \ge u_{BE}$

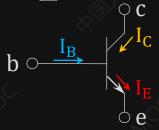
饱和区: $u_{BE} > U_{on} 且 u_{CE} < u_{BE}$

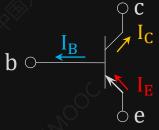
截止区: $u_{BE} \le U_{on}$ 且 $u_{CE} > u_{BE}$

5、三极管工作在<mark>放大状态</mark>时的电流关系以及方向: $\left\{\begin{array}{l} I_C = \beta I_B \\ I_R = I_C + I_B = (1+\beta)I_B \end{array}\right\}$

$$\begin{cases} I_{C} = \beta I_{B} \\ I_{E} = I_{C} + I_{B} = (1 + \beta)I_{B} \end{cases}$$

NPN型:





 I_E 与e极箭头的方向相同 I_E 与 I_B 、 I_C 的方向相反 <

 I_E 流入三极管, I_B 、 I_C 流出三极管

 I_{E} 流出三极管, I_{B} 、 I_{C} 流入三极管

6、三极管工作在<mark>放大状态</mark>时三个电极对地电压的大小关系

 $NPN型: U_C>U_B>U_E$

【PNP型: U_C<U_B<U_E

NPN型:

7、温度对三极管的影响 ── 温度升高 〈三极管发射结管压降UBE减小

三极管集电结反向饱和电流增大

三极管电流放大系数β增大

三极管输入特性曲线左移

、三极管输出特性曲线上移, 输出特性曲线之间的间隔增大

- 8、反向饱和电流越小,三极管的稳定性能越好
- 9、硅三极管的温度稳定性能比锗三极管好
- 10、三极管是电流控制型元件 ── 电流放大作用: $I_C = \beta I_B$ ── 电流控制电流: I_B 控制 I_C

场效应管是电压控制型元件 ——— 电流放大作用: $i_D = f(u_{GS})$ ——— 电压控制电流: u_{GS} 控制 i_D

三极管参数β: 反应了基极电流对集电极电流的控制能力

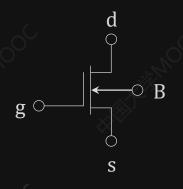
场效应管参数gm: 反应了栅-源电压对漏极电流的控制能力

场效应管

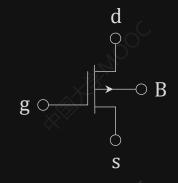
结型(JFET) 1、场效应管类型:场效应管(FET) < N沟道耗尽型 **耗**尽型 逸缘栅型(MOSFET) N沟道增强型 增强型 又称: MOS管

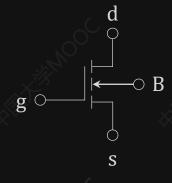


P沟道结型

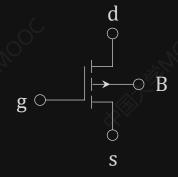


N沟道耗尽型





N沟道增强型



P沟道增强型

场效应管

2. 场效应管的三个电极分别是: 栅极g、漏极d、源极s

漏极d和源极s之间的非耗尽层区域称为导电沟道

3. 场效应管的UGS(th)或UGS(off)正负情况:



4. 场效应管的工作区域: 恒流区 夹断区